

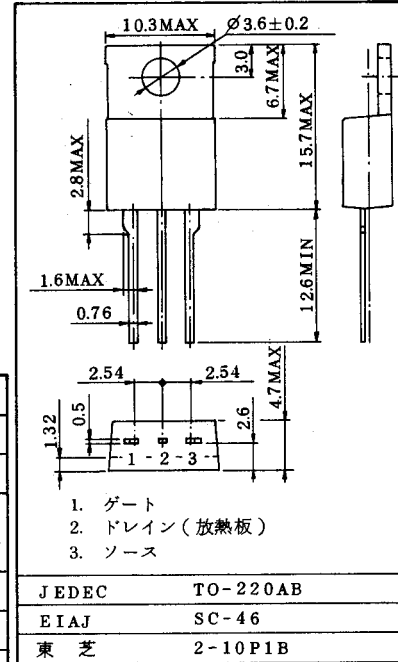
2SK791

- 高速高電圧スイッチング用
- スwitchングレギュレータ
- モータドライブ用

通信工業用

単位: mm

- ・ 高耐圧です。 : $V_{(BR)DSS} = 850V$
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。
 : $|Y_{fs}| = 1.0S$ (標準) ($I_D = 1.5A$)
- ・ 漏れ電流が低い。 : $I_{GSS} = \pm 100nA$ (標準) ($V_{GS} = \pm 20V$)
 : $I_{DSS} = 300\mu A$ (最大) ($V_{DS} = 850V$)
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。

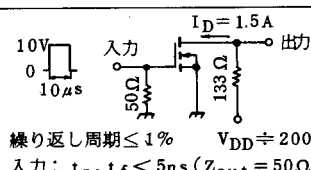


最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| ドレイン・ソース間電圧 | V_{DSX} | 850 | V |
| ゲート・ソース間電圧 | V_{GSS} | ± 20 | V |
| ドレイン電流 | DC | 3 | A |
| | パルス | 5 | |
| 許容損失 ($T_c = 25^\circ C$) | PD | 100 | W |
| チャンネル温度 | T_{ch} | 150 | $^\circ C$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -55 ~ 150 | $^\circ C$ |

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

| 項目 | 記号 | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---------------|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------|----------|
| ゲート漏れ電流 | I_{GSS} | $V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0$ | - | - | ± 100 | nA |
| ドレイン遮断電流 | I_{DSS} | $V_{DS} = 850V, V_{GS} = 0$ | - | - | 300 | μA |
| ドレイン・ソース間降伏電圧 | $V_{(BR)DSS}$ | $I_D = 10mA, V_{GS} = 0$ | 850 | - | - | V |
| ゲートしきい値電圧 | V_{th} | $V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$ | 1.5 | - | 3.5 | V |
| 順方向伝達アドミタンス | $ Y_{fs} $ | $V_{DS} = 10V, I_D = 1.5A$ | 0.5 | 1.0 | - | S |
| ドレイン・ソース間オン抵抗 | $R_{DS(ON)}$ | $I_D = 1.5A, V_{GS} = 10V$ | - | 3.3 | 4.5 | Ω |
| ドレイン・ソース間オン電圧 | $V_{DS(ON)}$ | $I_D = 3A, V_{GS} = 10V$ | - | 12 | 15 | V |
| 入力容量 | C_{iss} | $V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | - | 800 | 1100 | pF |
| 帰還容量 | C_{rss} | $V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | - | 70 | 120 | pF |
| 出力容量 | C_{oss} | $V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$ | - | 120 | 200 | pF |
| スイッチング時間 | 上昇時間 | t_r | - | 55 | 120 | ns |
| | ターンオン時間 | t_{on} | - | 70 | 165 | |
| | 下降時間 | t_f | - | 60 | 120 | |
| | ターンオフ時間 | t_{off} | - | 280 | 550 | |



この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。